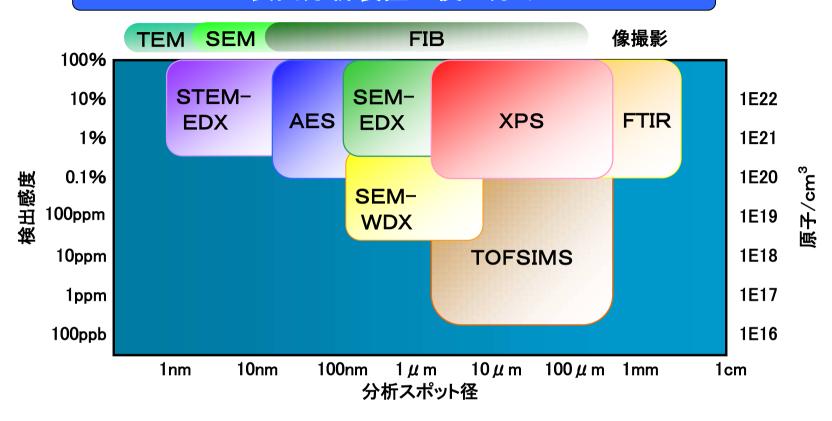


## 表面分析装置の使い分け



	AES	XPS	TOFSIMS
絶縁物	×	0	0
定量性	0	0	×
取得情報	×(元素情報のみ)	△(化学状態まで)	〇(構造・組成まで)
試料条件	×(微小化必要)	0	×(エッジ等に弱い)

表面分析手法の特徴



## TOFSIMS(飛行時間型二次イオン質量分析法)

## TOFSIMS (Time Of Flight-Secondary Ion Mass Spectrometry)



FE-AESやXPS、SEM/EDS分析よりも極表面の分析を得意とし、 金属化合物の形態や有機化合物の同定など詳細な情報を得ること ができる分析手法です。

高感度であり、かつ絶縁物の分析が可能であるTOFSIMSは シミや変色、構造評価等に有効です。

- 一次イオン源にBi銃を使用
- → Au/Ga銃(従来)よりも高感度分析が可能
- 極表層(数nm)を分析するためサンプル損傷がない。
- → 有機化合物の分析・薄膜(フィルム等)の分析が可能
- 異物やしみの分析が可能
- → イメージ像を作成することで測定領域のスペクトル 抽出が可能
- 電子中和銃を搭載
- → 絶縁物分析が可能
- スパッタガン(Cs/O<sub>2</sub>/Ar)を搭載
- → 深さ方向分析が可能

## 【主な用途】

- 極表面の金属・ハロゲン・無機酸・有機化合物の分析
- シミ部や変色部、汚染部の原因物質調査
- ウエハ製造工程等での洗浄評価
- 多層構造評価(剥離原因調査・接着不良調査等)